

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和7年2月21日(2025.2.21)

【国際公開番号】WO2024/014212

【出願番号】特願2024-533590(P2024-533590)

【国際特許分類】

H 0 1 F 17/00(2006.01)

H 0 1 F 27/00(2006.01)

H 0 1 G 4/30(2006.01)

H 0 1 G 4/40(2006.01)

H 0 1 G 4/33(2006.01)

H 1 0 D 1/20(2025.01)

H 0 1 L 21/3205(2006.01)

10

【F I】

H 0 1 F 17/00 B

H 0 1 F 27/00 S

H 0 1 G 4/30 5 4 1

H 0 1 G 4/40 3 2 1 A

H 0 1 G 4/33 1 0 2

H 1 0 D 1/20

H 0 1 L 21/88 Z

20

【手続補正書】

【提出日】令和6年12月11日(2024.12.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板と、

前記基板の面に沿って広がる絶縁体層と、

前記基板上又は前記絶縁体層内に形成され、前記基板の面に平行に面状に広がる単一又は複数の面状導体と、

前記絶縁体層上又は前記絶縁体層中に形成されたインダクタ用導体パターンと、を備え

、
前記基板の面に垂直方向から見て、前記インダクタ用導体パターンの形成領域と前記面状導体とが重なる単一の領域の長手方向の長さ、又は前記インダクタ用導体パターンの形成領域と前記面状導体とが重なる複数の領域の所定方向に合算した長手方向の長さを L_s で表し、前記インダクタ用導体パターンと前記インダクタ用導体パターンに最も近い前記面状導体との間隔を d で表すとき、 L_s / d の値が1以上60以下である、

40

電子部品。

【請求項2】

前記 L_s / d の値が1以上55以下である、

請求項1に記載の電子部品。

【請求項3】

前記基板と前記絶縁体層との間に形成された誘電体層を備え、

前記面状導体は前記誘電体層と共にキャパシタを構成するキャパシタ電極である、

50

請求項 1 又は 2 に記載の電子部品。

【請求項 4】

前記基板は低抵抗の半導体基板であり、

前記面状導体は前記半導体基板と共にキャパシタを構成するキャパシタ電極である、

請求項 1 又は 2 に記載の電子部品。

【請求項 5】

前記基板は半導体基板であり、

前記面状導体は前記半導体基板と共に半導体能動素子を構成する、

請求項 1 又は 2 に記載の電子部品。

【請求項 6】

前記面状導体は抵抗薄膜である、

請求項 1 又は 2 に記載の電子部品。

10

【請求項 7】

前記インダクタ用導体パターンは磁束が集中する磁束の開口を有し、当該開口に前記面状導体が配置されている、

請求項 1 又は 2 に記載の電子部品。

【請求項 8】

前記面状導体は前記開口の全体を覆おう、

請求項 7 に記載の電子部品。

20

30

40

50